

SIFAT OPTIK PADA FABRIKASI POLIKRISTAL AgGaSe_2

A. Harsono Soepardjo¹ dan I Dewa Made Janusetiawan²

1. Departemen Fisika, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

2. Program Pascasarjana Ilmu Material, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: psk_ui@yahoo.com

Abstrak

Polikristal AgGaSe_2 adalah senyawa (I-III-VI₂) suatu semikonduktor sebagai bahan dasar pembuatan lapisan tipis (*thin film*) untuk sel surya. Polikristal tersebut telah berhasil ditumbuhkan dengan metoda tungku Bridgmann tegak, dengan memanaskan sampai temperatur 850°C kemudian didinginkan perlahan-lahan sampai temperatur kamar. Hasil yang didapatkan berupa ingot (batangan) dengan panjang lebih kurang 3 cm dan diameter 13 mm. Dengan menggunakan *X-Ray Refraction* didapatkan komposisi masing masing unsur berat % adalah Ag = 29,3996 %, Ga = 36,8123 % dan Se = 30,29 % sedangkan pengukuran dengan *X-Ray Diffraction* didapatkan parameter kisinya dihitung $a = 4,4112 \text{ \AA}$, $c = 8,8854 \text{ \AA}$ dan $c/a = 2,01426$.

Abstract

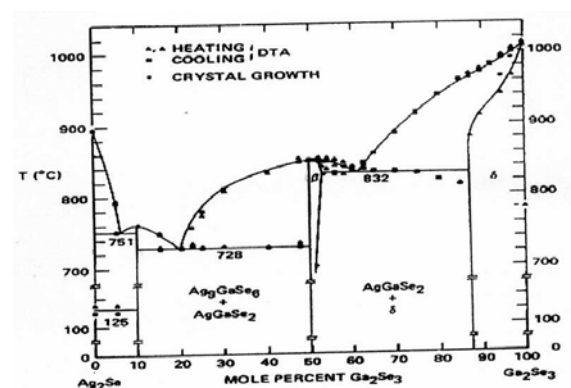
Optic Properties on AgGaSe_2 Polycrystal Fabrication. Polycrystal AgGaSe_2 , is compound (I-III-VI₂) a semiconductor as basic material for thin film for solar cell. Polycrystal was succesfully grown using Bridgmann Method, heated on sequential temperature treatment until 850°C and cooled down slowly until room temperature. Results observed were in the form of ingot (bars) with more or less 3 cm length and 13 mm in diameter. By using X-Ray Refraction, composition obtained of each element (weight %) was Ag = 29,3996 %, Ga = 36,8123 % and Se = 30,29 % while using X-Ray Diffraction lattice parameter obtained/calculated $a = 4,4112 \text{ \AA}$, $c = 8,8854 \text{ \AA}$, and $c/a = 2,01426$.

Keywords: Bridgmann Method, chalcopyrite, polycrystal AgGaSe_2 , lattice parameter.

1. Pendahuluan

Material (I-III-VI₂) adalah material yang bisa diharapkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sel surya. Sudah banyak diteliti bahwa bahan ini mempunyai nilai koefisien absorpsi yang cukup tinggi [2-4]. Salah satu material (I-III-VI₂) yang cukup banyak diteliti [5-8] adalah CuInSe_2 dan mempunyai efisiensi yang relatif tinggi yaitu 14,8 %. Pembuatan material (I-III-VI₂) ini relatif mudah dan murah. Dengan mengganti golongan Cu dengan Ag dan In dengan Ga maka material AgGaSe_2 bisa diharapkan menghasilkan sifat-sifat yang sama dengan CuInSe_2 . Struktur kristal AgGaSe_2 adalah *Chalcopyrite* dan parameter kisinya $a = b$ dan $c/a = 2,000$ dan titik cair bahan ini adalah 860°C. Diagram fasa dari material ini dapat dilihat pada Gambar 1 [9].

Pada tulisan disini akan dilakukan cara pembuatan AgGaSe_2 dan setelah itu akan dihitung parameter kisinya dengan menggunakan *X-Ray Diffraction*.



Gambar 1. Diagram fasa AgGaSe_2 [9]

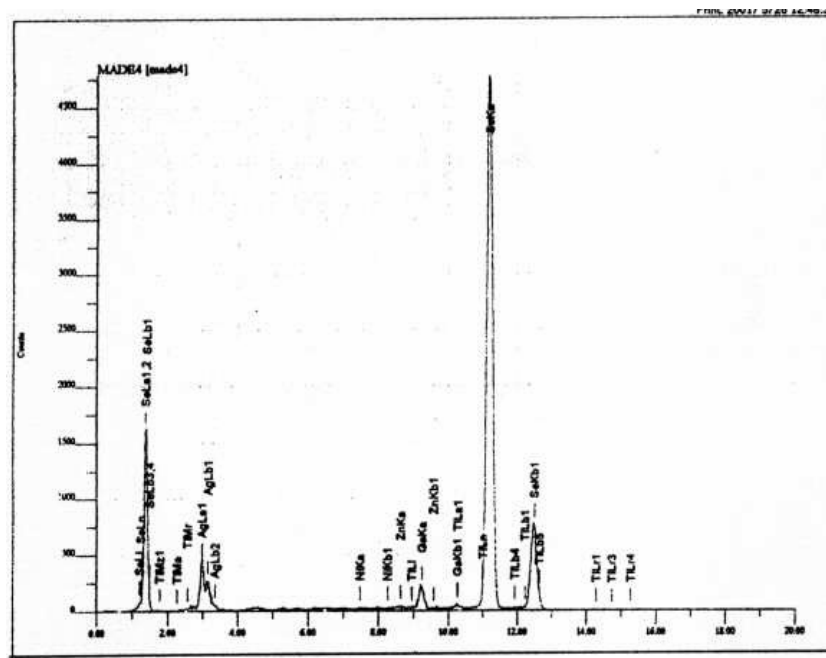
Tabel 1. Kecepatan peningkatan dan penurunan temperatur

Tahap ke	Mulai (°C)	Akhir (°C)	Waktu (jam)	Kecepatan (°C/jam)
1	25	200	8	22
2	200	200	24	0
3	200	750	5	110
4	750	750	4	0
5	750	1000	5	50
6	1000	1000	4	0
7	1000	850	4	-38
8	850	850	4	0
9	850	25	20	-41

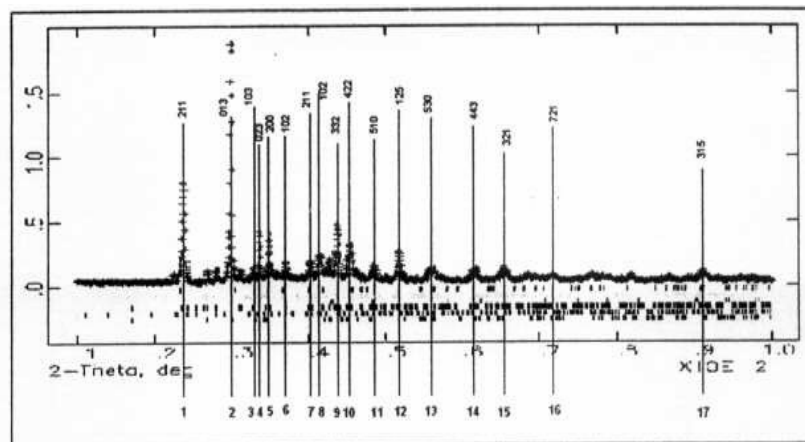
3. Hasil dan Pembahasan

Selanjutnya dengan memperhatikan sifat-sifat masing-masing unsur Ag, Ga dan Se (titik didihnya) dan diagram fasa AgGaSe_2 maka proses penumbuhannya dapat digambarkan pada Gambar 3.

Pengukuran sampel dengan menggunakan *X-Ray Refraction (XRF)*. Pengukuran sampel dilakukan di laboratorium Pascasarjana Ilmu Material Salemba yang dilakukan untuk beberapa sampel. Hasil pengukuran salah satu sampel tersebut diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Pengukuran sampel dengan XRF.



Gambar 5. Hasil pengukuran dengan XRD

Tabel 2. Pembentukan fasa dan indeks Miller yang terjadi

Sampel 5				
dθ	d(Å)	Puncak	Fasa	h k l
22,715	3,910	1	2	2 1 1
29,456	3,029	2	2	0 1 3
33,542	2,669	3	1	1 0 3
33,701	2,656	4	2	0 2 3
34,694	2,583	5	1	2 0 0
36,042	2,489	6	3	1 0 2
40,426	2,229	7	1	2 1 1
42,144	2,142	8	3	1 0 2
44,307	2,042	9	2	3 3 2
46,389	1,955	10	2	4 2 2
48,402	1,878	11	2	5 1 0
52,252	1,749	12	2	1 2 5
55,911	1,643	13	2	5 3 0
61,966	1,496	14	2	4 4 3
66,016	1,414	15	1	3 2 1
72,426	1,303	16	2	7 2 1
92,159	1,069	17	3	3 1 5

Keterangan:

- 1: Fasa AgGaSe₂
- 2: Fasa Ag₉GaSe₆
- 3: Fasa Ag₂Se

Dari hasil pengukuran dengan *XRF* didapatkan kandungan masing-masing unsurnya wt % adalah Ag = 29,3996 %, Ga = 36,8123 % dan Se = 30,29 %.

Pengukuran sampel dengan *X-Ray Diffraction (XRD)* juga dilakukan di laboratorium yang sama. Pengukuran dilakukan untuk beberapa sampel. Hasil pengukuran salah satu sampel tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

Dari hasil pengukuran *XRD* dapat dihitung parameter kisi kisinya a,b,c dan c/a. Setelah itu dengan menggunakan metoda GISAS dapat dicocokkan posisi puncak-puncak yang terjadi pada hasil *XRD* tersebut. Pembentukan fasa dan indeks Miller yang terjadi diperlihatkan pada Tabel 2.

4. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan juga pengamatan pada proses penumbuhan polikristal

AgGaSe₂ maka dapat disimpulkan bahwa hasil ingot/batangan yang diperoleh secara visual cukup baik, hanya saja hasil *XRF* yang didapat belum menunjukkan stoikiometrik material AgGaSe₂. Dari *XRF* ditunjukkan wt % Ag = 29,3996 %, Ga = 36,8123 % dan Se = 30,29 %. Hal ini berarti bahwa ingot yang diperoleh belum cukup homogen. Secara umum parameter kisi yang dihasilkan adalah a = 4,4112 Å, c = 8,8854 Å dan c/a = 2,01426. Ini menunjukkan bahwa struktur AgGaSe₂ adalah *chalcopirite*. Disarankan pada penelitian disini, agar hasilnya lebih baik maka pada saat proses penumbuhan polikristal AgGaSe₂ pengadukannya/*rocking* supaya dibantu suatu motor yang putarannya lebih rendah.

Daftar Acuan

- [1] I Dewa Made Janusetiawan, Tesis Magister, Program Studi Ilmu Material, Program Pascasarjana FMIPA, Universitas Indonesia, Indonesia, 2001.
- [2] L. L. Kazmerski, F. R. White, M. S. Ayyagari, Y. J. Juang, R. P. Patterson, J. Vac. Sci. Technol. 14 (1977) 65.
- [3] S. Isomura, A. Nagamatsu, K. Shinohara, T. Aono, Solar Cell 16 (1986) 143.
- [4] R. Noufi, J. Dick, J. Appl. Phys. 58 (1985) 3884.
- [5] L. Stolt, J. Hedström, J. Kessler, M. Ruckh, K-O. Velthaus, H-W. Schock, Appl. Phys. Lett. 62 (1993) 597.
- [6] R. W. Birkmire, J. L. Phillips, Stable High Efficiency CuInSe₂ Based Polycrystalline Thin Films Tandem Solar Cell, Final Report, S.E.R.I Report No.SERI/STR 211-3249, 1987.
- [7] L. S. Palatnik, E. K. Belova, Neorgan. Mater.3 (1967) 2194.
- [8] A. Congiu, L. Garbado, P. Manca, Mat. Res. Bull. 8 (1973) 293.
- [9] D.W. Jones, In: C.H.L Goodmann (Ed.), Refractory Metal Crystal Growth Techniques, Crystal Growth Theory and Technique, vol. 1, Plenum Press, New York, 1980.
- [10] A.H. Soepardjo, Dr. Thesis, Universite Montpellier II, Perancis, 1993.